

# وصف مقرر دراسي Course Description

متطلب متزامن	متطلب سابق	تمارين	عملي	نظري	الساعات	اســــــم المقـــــرر	رقم ورمز المقرر
Co-Req.	Pre-Req	TU	LB	LT	CR	Course Title	Course Code
_	202 كهر	1		2	٥	إلكترونيات - 1	312 كهر
-	EE 202	ı	_	3	3	Electronics - 1	EE 312

### محتويات المقرر:

مقدمة لأشباه الموصلات تشمل: الشبكيه البللورية و الروابط و شرائط الطاقة فى الجوامد – أشباه الموصلات الذاتية و المطعمة بالشوائب – توزيع فيرمى ديــراك – مستوى فيرمى – تركيز حاملات الشحنات من الالكترونات و الثقوب فى أشباه الموصلات حصادم حاملات الشحنة و التوصيلية، انتشار حاملات الشحنة و توليد و تركيب حاملات الشحنة و زمن الحياة – معادلات الانتقال فى أشباه الموصلات. نظريه الوصلة الثنائية و تشمل: تكوين الموصلات الثنائية و خواص الجهد مع التيار فيها. تطبيقات الموصلات الثنائية و تشمل التوحيد و دايود الزنر و الخلايا الشمسية و الدايود المشع للضوء. ترانزستور الموصلة و الشائية و تشمل التكبير – نسق تشغيل ترانزستور الموصلة و توصيف التيارات المارة فيه و معامل التكبير – نسق تشغيل ترانزستور الموصلة و طرق تطبيق جهد الانجياز – نقطة التشغيل معادلات ابرز مول للجهد مع التيار – نموذج الاشارات الصغيرة لترانزستور الموصلة و تشغيله كمكبر فى الدوئر الالكترونيه. نبائط القدرة و تشمل موحد السيليكون المحكوم الثايرستور و الترايـاك – ترانزســتور الموصلة المعبرة و تشغيله كمكبر فى الدوئر الالكترونيه. نبائط القدرة و تشمل موحد السيليكون المحكوم الثايرستور و الترايـاك – ترانزســتور الموصلة المعبرة و تشغيله كمكبر فى الدوئر الالكترونيه. نبائط القدرة و تشمل موحد السيليكون المحكوم الثايرستور و الترايـاك – ترانزســتور الموصلة المعبرة و تشغيله كمكبر فى الدوئر الالكترونيه. نبائط القدرة و تشمل موحد السيليكون المحكوم الثايرستور و الترايـاك – ترانزســتور الموصلة المعبرة و تشغيله كمكبر فى الدوئر الالكترونيه. نبائط القدرة و تشمل موحد السيليكون المحكوم الثايرستور و الترايـاك – ترانزســتور الموصلة المعبرول البوابة IGBT المعبرول البوابة IGBT المعبرول البوابة الموحد السيليكون المحكوم الثاير المورد و الترايـاك – ترانزســتور المورد المورد المعبرون المحكوم الثاير المعرد المورد ا

### Course Contents:

Introduction to Semiconductors, including: Crystal lattice, bonds and energy bands in solids. P-N Junction including: Junction formation, I-V characteristics, forward and reverse bias, breakdown voltage. Applications of P-N Junction including Rectification, Zener diode, solar cells and light emitting diode (LED). Bipolar Junction Transistor (BJT), including: BJT types and operation, and its currents and current amplification factor. BJT modes of operation and biasing configurations. BJT current equations and Ebers Moll model. Operating point and bias stability. BJT small signal models and BJT operation as an amplifier. Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor (MOSFET), including: MOSFET types and theory of operation. Channel formation in Enhancement-mode MOSFET and its I-V characteristics in linear and saturation modes. MOSFET biasing configurations. MOSFET small signal models and MOSFET operation as an amplifier

## Course Objectives:

This course deals with the basic semiconductors devices. The main objective is to give the student a working knowledge of the characteristics of pn junction diodes, BJT's and FET's. To develop a student's ability to apply the device characteristics to the operation of basic electronic circuits using diodes BJT, FET, MOSFET. To give the student a working knowledge of different techniques used for the analysis and design of basic electronic circuits

### **Evaluation Methods:**

- 1. Midterm exams
- 3. Quizzes

2. Assignments

4. Final exam

### Text Book and References:

- 1- Microelectronic Circuits, A. Sedra and K. Smith, Mc-Graw-Hills, NY, 2004.
- 2- Microelectronics, J. Millman and Arvin Grabel, McGraw Hills, NY, 2000